## 电子在周期驱动耦合量子阱中的振荡

段  $(\mathbb{P}^{1})$  赖云忠<sup>12</sup> 严启伟<sup>2</sup> 梁九卿<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(山西大学理论物理研究所,太原 030006) <sup>2</sup>(中国科学院物理研究所,北京 100080) (2002年11月11日收到 2002年12月19日收到修改稿)

通过精确求解含时的量子体系,研究了在周期耦合驱动下电子在两量子阱中的受迫振荡.电子在双量子阱间 的隧穿可由周期性外场控制.得到了电子被囚禁在单一量子阱中的条件.

关键词:量子阱,受迫振荡,周期驱动 PACC:0365,0560

## 1.引 言

近年来,由于在输运过程中研究单电子效应已 成为可能,电子在量子阱中的输运问题引起了广泛 关注.但研究的重点仍集中在单量子阱,而微加工工 艺的快速发展已可以制造耦合的量子阱系统,如一 个耦合的量子阱分别与两个电极相连<sup>[1-6]</sup>.与单量 子阱相比,电子将会在耦合的量子阱中振荡.这种量 子关联必然会影响整个系统中的电流,因而研究单 电子在周期驱动耦合量子阱中的动力学是十分有意 义的.

#### 2. 模型和精确解

如图 1 所示,当远离发射极和集电极时,电子在 周期驱动的耦合量子阱中的 Hamiltonian 为

 $\hat{H} = E_{+} \hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} + E_{-} \hat{a}_{-}^{+} \hat{a}_{-}$ 

+  $\Omega_0(\hat{a}_+^* \hat{a}_- e^{i\omega t} + \hat{a}_+^* \hat{a}_+ e^{-i\omega t})$ , (1) 式中 , $\hat{a}_i^*$  , $\hat{a}_i$  表示在电子能级  $E_i$  上的产生和湮没算 符 ,满足通常的反对易关系 :{ $\hat{a}_i$  , $\hat{a}_j^+$  }=  $\delta_{ij}$  , $\Omega_0$  为周 期耦合驱动振幅 , $\omega$  为驱动频率.



图1 电子在耦合量子阱中的振荡

取  $E_+$  与  $E_-$  的平均值为零点能,系统的 Hamiltonian 变为

$$\hat{H} = \frac{E_{+} - E_{-}}{2} (\hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} - \hat{a}_{-}^{+} \hat{a}_{-}) \\ + \Omega_{0} (\hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{-} e^{i\omega t} + \hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} e^{-i\omega t}) \\ = \varepsilon \hat{K}_{0} + \Omega_{0} (\hat{K}_{+} e^{i\omega t} + \hat{K}_{-} e^{-i\omega t}), \quad (2)$$
$$\vec{X} \Psi \varepsilon = E_{+} - E_{-} \notagge + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\hat{K}_{0} = \frac{1}{2} (\hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} - \hat{a}_{-}^{+} \hat{a}_{-}),$$

$$\hat{K}_{+} = \hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{-} ,$$

$$\hat{K}_{-} = \hat{a}_{-}^{+} \hat{a}_{+} ,$$

$$\hat{K}_{+} = (\hat{K}_{-})^{+} .$$

可以证明  $\hat{K}_0$   $\hat{K}_+$  与  $\hat{K}_-$  对易关系为

$$\left[ \begin{array}{c} \hat{K}_0 \\ \hat{K}_{\pm} \end{array} \right] = \pm \begin{array}{c} \hat{K}_{\pm} \\ \mu \end{array} ,$$

$$[\hat{K}_{+},\hat{K}_{-}] = 2\hat{K}_{0}.$$
 (3)

含时 Schrödinger 方程为

$$i \frac{d}{dt} \mid \Psi(t) = \hat{H}(t) \mid \Psi(t). \quad (4)$$

取 ħ = 1.

为求解此含时体系,作如下幺正变换:

$$|\Psi(t) = \hat{R}(t)|\Psi'(t), \quad (5)$$

式中,Â(t)为幺正算符,

$$\hat{R}(t) = \exp\left[\frac{\gamma(t)}{2} (\hat{K}_{+} e^{-i\beta(t)} - \hat{K}_{-} e^{i\beta(t)})\right].$$
(6)

代入 Schrödinger 方程(4),得到 |  $\Psi'(t)$  满足的 含时方程

$$i \frac{d}{dt} \mid \Psi' = (\hat{R}^+ (t)\hat{H}(t)\hat{R}(t))$$

$$\hat{R}^{+}(t)\hat{K}_{0}\hat{R}(t) = \hat{K}_{0}\cos\gamma + \frac{1}{2}(\hat{K}_{+}e^{-i\beta} + \hat{K}_{-}e^{i\beta})\sin\gamma,$$
(8)

$$\hat{R}^{+}(t)\hat{K}_{+}\hat{R}(t) = \hat{K}_{+}\cos^{2}\frac{\gamma}{2} - \hat{K}_{-}e^{i\beta}\sin^{2}\frac{\gamma}{2} - \hat{K}_{0}e^{i\beta}\sin\gamma, \qquad (9)$$

$$\hat{R}^{+}(t)\hat{K}_{-}\hat{R}(t) = \hat{K}_{-}\cos^{2}\frac{\gamma}{2} - \hat{K}_{+}e^{-i2\beta}\sin^{2}\frac{\gamma}{2} - \hat{K}_{0}e^{-i\beta}\sin\gamma, \qquad (10)$$

$$\begin{split} \hat{R}^{+}(t)\hat{R}(t) &= -2\hat{K}_{0}\dot{\beta}\sin^{2}\frac{\gamma}{2} \\ &+ \hat{K}_{+}e^{-i\beta}\left(i\frac{\dot{\gamma}}{2} + \frac{\dot{\beta}}{2}\sin\gamma\right) \\ &+ \hat{K}_{-}e^{i\beta}\left(-i\frac{\dot{\gamma}}{2} + \frac{\dot{\beta}}{2}\sin\gamma\right), (11) \end{split}$$

取

$$\dot{\gamma} = 2\Omega_0 \sin(\omega t + \beta),$$

$$\frac{1}{2}(\dot{\beta} - \varepsilon)\sin\gamma = \Omega_0\cos\gamma\cos(\omega t + \beta). \quad (12)$$

将(8—12) 武代入 Schrödinger 方程,得

$$i \frac{d}{dt} | \Psi'(t) = (\cos \gamma - \frac{(\beta + \omega t)}{\Omega_0} \sin \gamma - e^{-(\beta + \omega t)} \Omega_0 \sin \gamma + 2\dot{\beta} \sin^2 \frac{\gamma}{2} \hat{K}_0 | \Psi'(t) . (13)$$
  
考虑绝热近似 ,  $\dot{\gamma} = 0$ ,  $\dot{\beta} = 0$ , 由(13)式得

$$\beta = 2n\pi - \omega t$$
$$\frac{1}{2}\varepsilon \sin\gamma + \Omega_0 \cos\gamma = 0.$$

(13) 武简化为

式中

1

$$i \frac{d}{dt} \mid \Psi'(t) = \left(\varepsilon - 2\varepsilon \sin^2 \frac{\gamma}{2} - 2\Omega_0 \sin\gamma\right) \hat{K}_0 \mid \Psi'(t) . (14)$$

对于远离发射极和集电极的耦合量子阱 , $\hat{K}_0$  的本征态为 | + , | – .

$$\hat{K}_{0} | + = \frac{1}{2} | + ,$$

$$\hat{K}_{0} | - = -\frac{1}{2} | - .$$

$$\text{根据文献 7-10], 5程(14)的通解为}$$

$$| \mathcal{W}(t) = C e^{i\alpha_{t}(t)} \hat{R}(t) | +$$

$$|\Psi(t) = C_{+} e^{i \alpha_{+}(t)} \hat{R}(t)| + C_{-} e^{i \alpha_{-}(t)} \hat{R}(t)| - , \quad (15)$$

$$\alpha_{\pm}(t) = \int_{0}^{t} \mathrm{d}t' \pm |\hat{R}(t')\hat{R}(t')|$$
$$-\hat{R}^{+}(t')\hat{H}(t')\hat{R}(t')| \pm . \quad (16)$$

在绝热近似下,

$$\alpha_n(t) = -K_n\left(\varepsilon - 2\varepsilon \sin^2 \frac{\gamma}{2} - 2\Omega_0 \sin\gamma\right)t ,$$
(17)

式中

$$K_{\pm}=\pm\,\frac{1}{2}\,.$$

*↓***Ψ**( t ) 也可写为

$$|\Psi(t) = \hat{U}(t) |\Psi(0)|$$

时间演化算符

$$\hat{U}(t) = \hat{R}(t) e^{-i\chi(t)\hat{K}_0} \hat{R}^+(0), \quad (18)$$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$$\chi(t) = \left(\varepsilon - 2\varepsilon \sin^2 \frac{\gamma}{2} - 2\Omega_0 \sin \gamma\right) t.$$

## 3. 电子布居数的时间演化

1) 设初始时刻, 电子处于高能级量子阱中,

则在 t 时刻 量子阱中粒子数之差的平均值为  $\overline{N}_{+-} = 2 \Psi(t) | \hat{K}_0 | \Psi(t)$   $= 2 + | \hat{U}^+(t)\hat{K}_0\hat{U}(t) | +$   $= 2 + | \hat{R}(0)e^{i\pi(t)\hat{K}_0} \Big[ \hat{K}_0\cos\gamma + \frac{1}{2}(\hat{K}_+ e^{i\beta} + \hat{K}_- e^{-i\beta})e^{i\pi(t)\hat{K}_0} \Big] e^{-i\pi(t)\hat{K}_0}\hat{R}^+(0) | +$   $= 2\cos\gamma + | \hat{R}(0)\hat{K}_0\hat{R}^+(0) | +$   $+ e^{i\pi(t)}e^{-i\beta}\sin\gamma + | \hat{R}(0)\hat{K}_+ \hat{R}^+(0) | +$   $+ e^{-i\pi(t)}e^{i\beta}\sin\gamma + | \hat{R}(0)\hat{K}_- \hat{R}^+(0) | +$   $= \cos^2\gamma + \frac{1}{2}e^{(\pi(t)-\beta)}\sin^2\gamma + \frac{1}{2}e^{-(\pi(t)-\beta)}\sin^2\gamma$   $= \frac{\epsilon^2}{4\Omega_0^2 + \epsilon^2} + \frac{4\Omega_0^2}{4\Omega_0^2 + \epsilon^2}\cos(\chi(t) - \beta)$   $= \frac{\epsilon^2}{4\Omega_0^2 + \epsilon^2} + \frac{4\Omega_0^2}{4\Omega_0^2 + \epsilon^2}\cos[(\omega - \sqrt{\epsilon^2 + 4\Omega_0^2})t].$ 

(19)

显然,当远离电极时,两量子阱中电子数之和为守恒量.

$$\overline{N} = \Psi(t) | \hat{N} | \Psi(t) \equiv 1, \quad (20)$$

 $\hat{N} = \hat{a}_1^+ \hat{a}_1 + \hat{a}_2^+ \hat{a}_2.$ 

故电子在高能级量子阱中的布居数随时间变化为

$$\bar{\mathbf{V}}_{+} = \Psi(t) | \hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} | \Psi(t)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon^{2}}{8\Omega_{0}^{2} + 2\varepsilon^{2}}$$

$$+ \frac{2\Omega_{0}^{2}}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}} \cos[(\omega - \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}})t]$$

$$= \frac{2\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}} + \frac{2\Omega_{0}^{2}}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}}$$

$$\times \cos[(\omega - \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}})t]. \quad (21)$$

2) 设初始时刻,电子处于叠加态,

$$| \Psi(0)_{e} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++|-),$$

$$| \Psi(0)_{e} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-|-),$$

在 *t* 时刻 ,电子在高能级量子阱中的布居数随时间 变化为

$$\overline{N}_{+}^{e} = \frac{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2} + 2\Omega_{0}\varepsilon}{8\Omega_{0}^{2} + 2\varepsilon^{2}}$$

$$- \frac{\Omega_{0}\varepsilon}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}} \cos\left\{\left(\omega - \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}}\right)t\right\}\left(22\right)$$

$$\overline{N}_{+}^{o} = \frac{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2} - 2\Omega_{0}\varepsilon}{8\Omega_{0}^{2} + 2\varepsilon^{2}}$$

$$+ \frac{\Omega_{0}\varepsilon}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}} \cos\left\{\left(\omega - \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}}\right)t\right\}\left(23\right)$$

3 设初始时刻,电子处于低能级量子阱中

$$\Psi(0) = |-$$

在 *t* 时刻 ,电子在高能级量子阱中的布居数随时间 变化为

$$\overline{N}_{+} = \Psi(t) | \hat{a}_{+}^{+} \hat{a}_{+} | \Psi(t)$$

$$= \frac{2\Omega_{0}^{2}}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}} - \frac{2\Omega_{0}^{2}}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}}$$

$$\times \cos\{\omega - \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}}\}t]. \quad (24)$$

4. 讨论

1)ω=0,由于隧穿耦合,电子仍在量子阱中作 周期振荡.

设电子初始处于高能级量子阱中 则

$$\overline{N}_{+} = \frac{2\Omega_0^2 + \varepsilon^2}{4\Omega_0^2 + \varepsilon^2} + \frac{2\Omega_0^2}{4\Omega_0^2 + \varepsilon^2} \cos\sqrt{\varepsilon^2 + 4\Omega_0^2} t.$$

此计算结果给出与文献 5 相同的结果.若此时两量 子阱能级差 ε = 0 ,电子在量子阱中振荡振幅最大, 即发生振幅共振,布居数变化为

$$\overline{N}_{+} = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\Omega_0 t).$$
 (26)

若电子初始处于叠加态

$$| \Psi(0)_{e} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+|+|-|),$$

则

$$\overline{N}_{+}^{e} = \frac{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2} + 2\Omega_{0}\varepsilon}{8\Omega_{0}^{2} + 2\varepsilon^{2}} - \frac{\Omega^{0}\varepsilon}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}}\cos\sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}}t. \quad (27)$$

当  $\varepsilon = 0$ , 布居数变化为  $\overline{N}_{+}^{e} = \frac{1}{2}$ , 即此时电子不会在量子阱中振荡.

若电子初始处于叠加态

$$| \Psi(0)_{o} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+|-|-|),$$

则

则

(25)

$$\overline{N}_{+}^{o} = \frac{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2} - 2\Omega_{0}\varepsilon}{8\Omega_{0}^{2} + 2\varepsilon^{2}} + \frac{\Omega_{0}\varepsilon}{4\Omega_{0}^{2} + \varepsilon^{2}}\cos\sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}}t. \quad (28)$$

当  $\varepsilon = 0$  ,布居数变化为  $\overline{N}_{+}^{\circ} = \frac{1}{2}$  ,此时电子也不会在量子阱中振荡.

若电子初始处于低能级中 则

$$\overline{N}_{+} = \frac{2\Omega_0^2}{4\Omega_0^2 + \varepsilon^2} \left[ 1 - \cos\left(\sqrt{\varepsilon^2 + 4\Omega_0^2} t\right) \right]. (29)$$

当 $\varepsilon = 0$ , 布居数变化为

$$\overline{N}_{+} = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\Omega_0 t).$$
 (30)

2)ω≠0 若驱动频率

$$\omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4\Omega_0^2} \, ,$$

此时无论初始状态如何,电子始终被囚禁在量子阱 中,布居数不再随时间变化.

若电子初始处于高能级量子阱中 则

$$N_{+} = 1$$

电子被囚禁在高能级量子阱中.

若电子初始处于叠加态 $|\Psi(0)_{e}$ 或 $|\Psi(0)_{e}$ ,

$$\overline{N}_+ = \frac{1}{2}$$
 ,

电子始终以相同概率处于两量子阱中.

若电子初始处于低能级量子阱中 则  

$$\overline{N}_{+} = 0$$
,  
电子被囚禁在低能级量子阱中.  
 $3 \ \omega \neq 0 \ \omega \neq \sqrt{\varepsilon^{2} + 4\Omega_{0}^{2}} \ \epsilon = 0.$   
若电子初始处于高能级量子阱中 则  
 $\overline{N}_{+} = \frac{1}{2} [1 + \cos(\omega - 2\Omega_{0})t]$ ,  
电子将在量子阱作振幅最大的振动.  
若电子初始处于叠加态 |  $\Psi(0)_{\circ}$  或 |  $\Psi(0)_{\epsilon}$  则  
 $\overline{N}_{+} = \frac{1}{2}$ ,

电子将被局域在两量子阱中,不再振动. 若电子初始处于低能级量子阱中,则

$$\overline{N}_{+} = \frac{1}{2} [1 - \cos(\omega - 2\Omega_0)t]$$

电子将作振幅最大的振动.

### 5.结论

本文分析了在含时耦合驱动下,由不同状态开始,电子在两个量子阱之间的振荡行为.得到振荡振幅和频率与耦合驱动振幅、频率及两量子阱间能级差的依赖关系.若电子初始处于某一量子阱中,当驱动频率  $\omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4\Omega_0^2}$ 时,电子在量子阱中的布居数不再随时间变化.若电子初始处于叠加态,则在另外一种情况下即两量子阱能级差为零时,电子在量子阱中的布居数也不随时间改变.此时电子被稳定地局域在量子阱中,故可以通过周期性外场来控制电子在耦合量子阱中的隧穿,以控制整个体系电流.

- [1] Hang R J , Hong J M , Lee K Y 1992 Surf. Sci. 263 415
- [2] Vander Varrt N C, Godijn S F, Nazzarov Y V et al 1995 Phys. Rev. Lett. 74 4702
- [3] Waugh F R , Berry M J , Mar D J et al 1995 Phys. Rev. Lett. 75 4702
- [4] Gurvitz S A , Prager Y S 1996 Phys. Rev. B 53 15932
- [5] Gurvitz S A , 1997 Phys. Rev. B 57 6602
- [6] Gao X C, Gao J, Fu J 1996 Acta Phys. Sin. 45 923 (in Chinese) [高孝纯、高 隽、符 建 1996 物理学报 45 923]
- [7] Lai Y Z , Liang J Q , Muller-Kirsten H J W et al 1996 J. Phys. A 29 1773
- [8] Lai Y Z , Liang J Q , Muller-Kirsten H J W et al 1996 Phys. Rev. A 53 3691
- [9] Lai Y Z, Liang J Q 1996 Acta Phys. Sin. 45 738 (in Chinese) [赖 云忠、梁九卿 1996 物理学报 45 738]
- [10] Hou B P 2000 Acta Phys. Sin. 49 2118 (in Chinese) [侯邦品 2000 物理学报 49 2118]

# Electron oscillation between coupled quantum wells with periodic driving

Yin Wen<sup>1</sup><sup>(2)</sup> Lai Yun-Zhong<sup>1</sup><sup>(2)</sup> Yan Qi-Wei<sup>2)</sup> Liang Jiu-Qing<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>) (Institute of Theoretical Physics , Shanxi University ,Taiyuan 030006 ,China )

<sup>2</sup>)(Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

(Received 11 November 2002; revised manuscript received 19 December 2002)

#### Abstract

The behaviour of an electron between two quantum wells, is studied by exact solution of a time-dependent Schrödinger equation. The time-dependent electron occupation-probability is obtained analytically as a function of the energy difference between the two wells, coupling constant and driving frequency. The condition that electron can be trapped in a single quantum well is obtained.

Keywords : quantum wells , drived coupling , oscillation PACC : 0365 , 0560